

2SD772, 2SD772A, 2SD772B

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

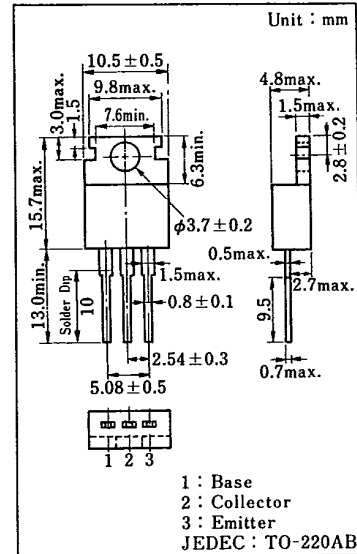
低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

■ 特徴 / Features

- コレクタ・ベース電圧 V_{CBO} が高い。 / High V_{CBO}
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Rating ($T=25^\circ\text{C}$)

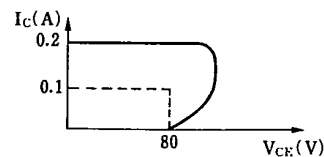
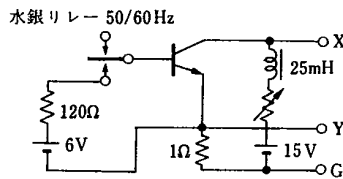
Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD772	150	V
	2SD772A	200	
	2SD772B	250	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD772	150	V
	2SD772A	200	
	2SD772B	250	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	80	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	40	A
コレクタ電流	I_C	5	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	40	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



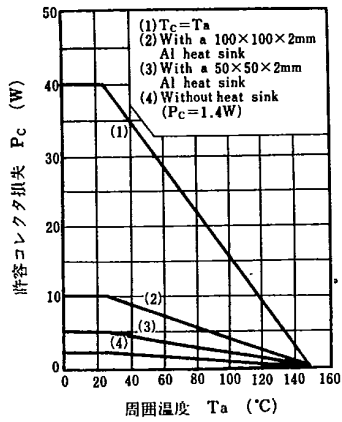
■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=150\text{V}, I_E=0$			1	mA
		$V_{CB}=200\text{V}, I_E=0$			1	
		$V_{CB}=150\text{V}, I_E=0$			1	
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO(sus)}$ *	$I_C=0.2\text{A}, L=25\text{mH}$	80			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	6			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=5\text{A}$	14			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=5\text{A}$			1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{A}, I_B=1\text{A}$			1.6	V
下降時間	t_f	$I_C=5\text{A}, I_{B1}=0.8\text{A}, -V_{EB}=5\text{V}$			1	μs
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.5\text{A}$		40		MHz

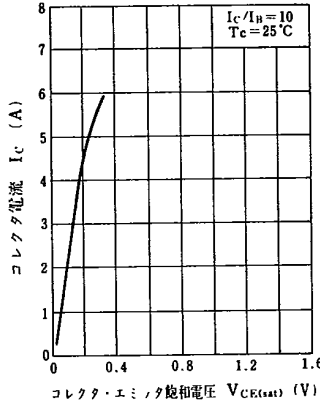
* $V_{CEO(sus)}$ 試験回路 / $V_{CEO(sus)}$ Test Circuit



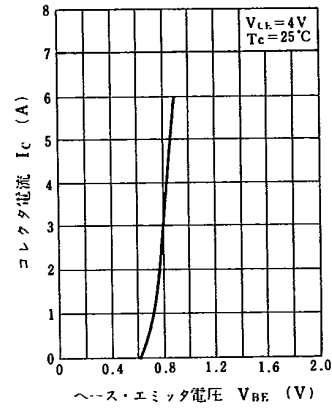
P_C-T_a



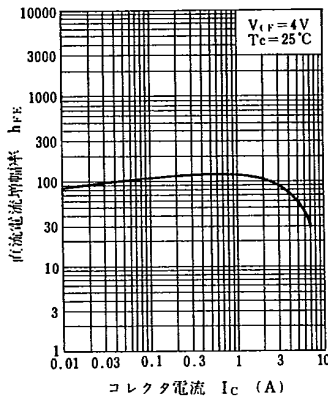
I_C-V_{CE(sat)}



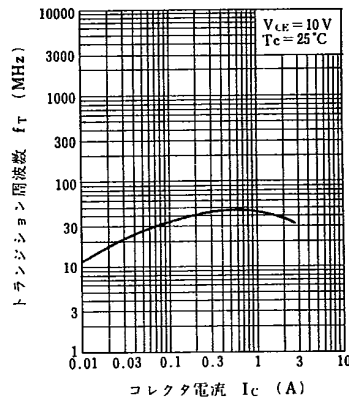
I_C-V_{BE}



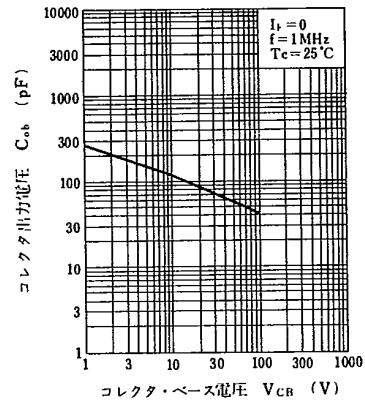
h_{FE}-I_C



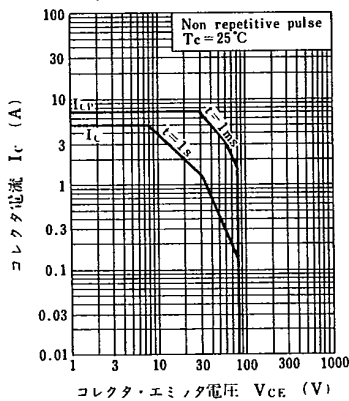
f_T-I_C



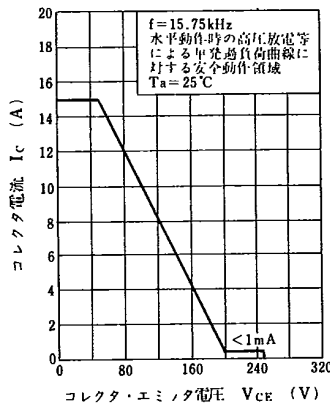
C_{ob}-V_{CB}

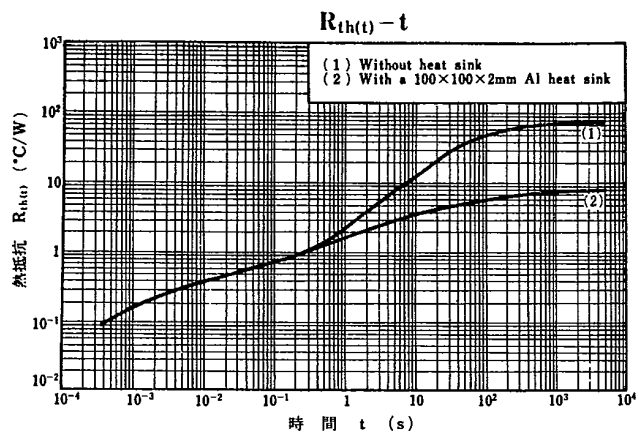


安全動作領域 ASO



安全動作領域 ASO





トランジスタ

T-33-11 2SD792

2SD792

シリコン NPN 三重拡散メサ形 / Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

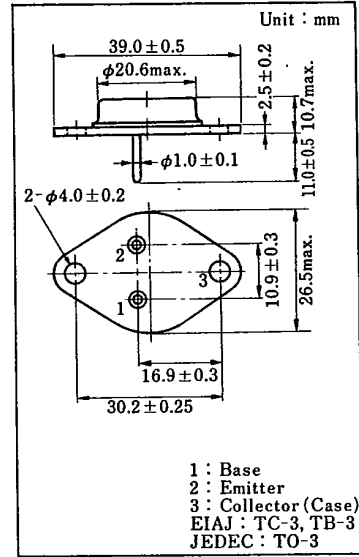
電源直結式水平偏向出力用 / Line-Operated Horizontal Deflection Output

■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ電圧 V_{CES} が高い。 / High V_{CES}
- セン頭コレクタ電流 I_{CP} が大きい。 / High I_{CP}
- 安全動作領域 (ASO) が広い。 / Wide area of safe operation (ASO)

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	1500	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	4	V
セン頭コレクタ電流	I_{CP}	7	A
コレクタ電流	I_C	5	A
コレクタ損失 ($T_c \leq 90^\circ\text{C}$)	P_C	35	W
接合部温度	T_J	130	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +130	$^\circ\text{C}$



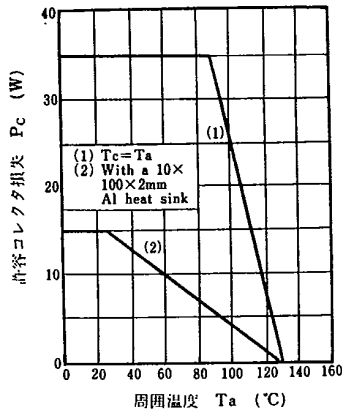
■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 750\text{ V}, I_E = 0$			50	μA
		$V_{CB} = 1500\text{ V}, I_E = 0$			1	mA
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10\text{ mA}, I_C = 0$	4			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 4\text{ A}$	4		12	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 4.5\text{ A}, I_B = 2\text{ A}$			1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 4.5\text{ A}, I_B = 2\text{ A}$			1.5	V
下降時間	t_r	$I_C = 4\text{ A}, I_{Bend} = 1.8\text{ A}, L_B = 10\ \mu\text{H}$			0.7	μs
蓄積時間	t_{stg}			13		μs

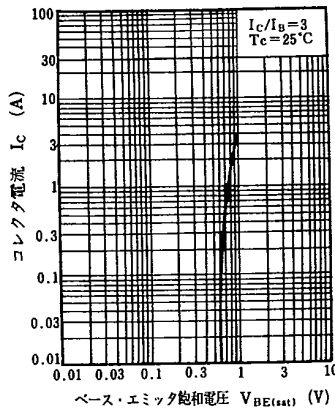
トランジスタ

T-33-11 2SD792

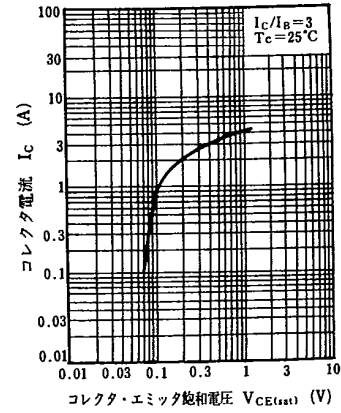
$P_C - T_a$



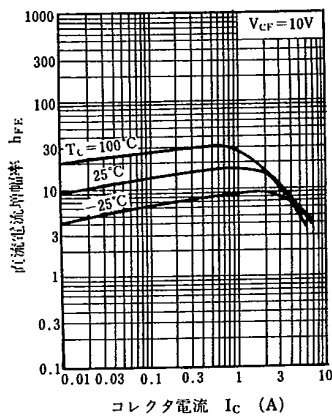
$I_C - V_{BE(sat)}$



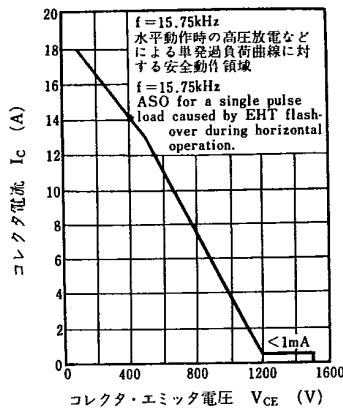
$I_C - V_{CE(sat)}$



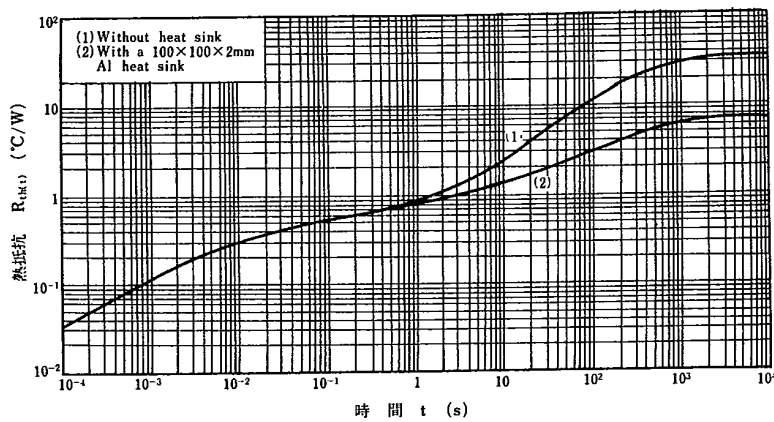
$h_{FE} - I_C$



安全動作領域 ASO



$R_{th(t)} - t$





LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

LittleDiode.com

Looking forward to providing you with the best possible service.